



碳纳米管复合薄膜场发射阴极的制备方法

文献类型: 专利

作者 陈婷; 洪序达; 陈焱; 孙竹; 桂建保; 郑海荣

发表日期 2012-12-15

专利国别 中国

专利号 201210544357.7

专利类型 发明

权利人 中国科学院深圳先进技术研究院

授权日期 2016-09-07

源URL [<http://ir.siat.ac.cn:8080/handle/172644/9490>]

专题 深圳先进技术研究院_先进院专利

作者单位 2012-12-15

推荐引用方式 陈婷,洪序达,陈焱,等. 碳纳米管复合薄膜场发射阴极的制备方法. 201210544357.7. 2012-12-15.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [深圳先进技术研究院](#)

浏览	下载	收藏
17	0	0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

